

FCSJ-16-003

2016 年 3 月 22 日

～フェアチャイルドが担ってきたパワートレンチ MOSFET に、100V MOSFET 製品を新たに追加～
フェアチャイルド、クラス最高性能を誇る

新世代の PowerTrench MOSFET 「FDMS86181」を発表

40%低減したオン抵抗($R_{ds(on)}$)と、ずば抜けて低い逆回復電荷(Q_{rr})を同時に実現

本日(2016 年 3 月 22 日)、[フェアチャイルドセミコンダクタージャパン](#)株式会社(本社：東京都渋谷区、社長：神戸 肇、以下フェアチャイルド・ジャパンと略す)は、最新世代の 100V 耐圧 N-チャネル MOSFET の主力製品となる 100V シールドゲート PowerTrench® MOSFET 「[FDMS86181](#)」を発表しました。この「FDMS86181」はフェアチャイルドの最新世代のパワートレンチ MOSFET 技術を用いた第一弾の製品で、効率化への飛躍的な改善と 100V MOSFET を使用せざる得ない電源やモーターその他のアプリケーションにおいて電圧リンギングの低減と低 EMI(電磁干渉)を実現します。

フェアチャイルドは約 25 年前からパワートレンチ MOSFET を推し進め、それを成功させてきた先駆者です。そしてその最新世代の MOSFET 製品は、顧客の電源システムにおけるほぼ全ての要求に答え、競合他社に先んじ、且つこれまでと同様にフェアチャイルドを MOSFET 技術開発のトップランナーと位置づけるものです。

“フェアチャイルドのこの新たな 100V N-チャネル MOSFET は、業界をリードして来た現行の PowerTrench MOSFET を大躍進させたものです。その特性が飛躍的に改善され、且つほとんどの競合他社製品に対し、その効率から信頼性までのすべての性能項目で勝っています。”とフェアチャイルドの iFET 製品部門のゼネラルマネージャーの Suman Narayan は語っています。

この新たな「FDMS86181」の最大の利点は導通損失に寄与するオン抵抗($R_{ds(on)}$)を 40%低減し、同時にスイッチング損失を低減するゲート電荷(Q_g)の最小化を実現していることです。さらに、ずば抜けて低い逆回復電荷(Q_{rr})はリンギングの発生源となる電圧のオーバーシュートをほとんど除去すると同時に、製品設計におけるスナバの削減もしくは除去及び EMI の低減を可能にします。この類を見ない利点により、「FDMS86181」は基板サイズと基板上の部品コスト(BOM)の双方を同時に削減します。

新製品 100V パワートレンチ MOSFET のサンプルおよび詳細については、[PowerTrench MOSFET の製品フォルダー](#)をご覧ください。

フェアチャイルドとフェアチャイルド・ジャパンにつきまして：

フェアチャイルドには半導体業界におけるパイオニアとしての永い歴史があり、そのパイオニア精神は、クリーンかつスマートな世界を目指した当社のビジョンの中に今日まで受け継がれています。低～高電力ソリューションへの幅広い製品群の開発と製造に特化し、携帯機器、産業、クラウド、車載、照明ならびにコンピューター分野のエンジニアやシステム設計者の方々に卓越した設計ソリューションと感動するほどの設計体験をお届けしています。

フェアチャイルドセミコンダクタージャパン株式会社は1997年2月設立。2015年1月より、神戸肇が代表取締役を務めると同時に米国本社への直轄体制となりました。

「Power to Amaze」に満ちたフェアチャイルドの新しい[ウェブサイト](#)については、こちらをご覧ください。

報道関係からのお問い合わせ：

高瀬 健男	TEL：03-6367-9191	携帯：080-9297-1653
	takeo.takase@fairchildsemi.com	
畑 博美	TEL：03-6367-9136	
	hiromi.hata@fairchildsemi.com	

フェアチャイルドセミコンダクタージャパン株式会社
〒150-0013 東京都渋谷区 恵比寿 4-1-18 恵比寿ネオナート 3F

以上